

## Кремний (Si)

**Производитель:**

АО «Диполь Технологии»

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Монокристаллический кремний – основа для производства полупроводниковых приборов. ИМЭ на основе Si составляет 98% всех производимых в мире полупроводниковых приборов.

Кремний имеет оптимальное значение ширины запрещенной зоны, которая обусловила достаточно низкую концентрацию собственных носителей и высокую рабочую температуру.

### Применение

Полупроводники из кремния широко применяются для создания интегральных микросхем, биполярных и полевых транзисторов, приборов с зарядовой связью, быстродействующих фотодиодов и многих других устройств. А продукты на основе кремния, такие как MOSFET или IGBT-транзисторы с суперпереходом, можно использовать в широком диапазоне напряжений (от единиц до нескольких сот вольт) и в различных классах мощности.

## Спецификация

Si						
Диаметр	2"	3"	4"	5"	6"	8"
Метод выращивания	MCZ / GDFZ / NTD					
Ориентация	< 1-0-0 >, < 1-1-1 >, < 1-1-0 >					
Тип проводимости / легирующая примесь	P/B, N/P, N/As, N/Sb					
Толщина (мкм)	279	380	525	625	675	725
Удельное сопротивление (Ω·см)	MCZ: $1 \cdot 10^3 - 100$ , GDFZ: $1 \cdot 10^3 - 20000$ , NTD: 30 – 600					
TTV (мкм)	≤ 10					
Bow/Warp (мкм)	< 40					

Подложки Si с другими параметрами доступны по запросу. Доступны слитки и эпитаксиальные структуры на основе Si. Производство: Китай.